

中信建投证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：拓荆科技股份有限公司
保荐代表人姓名：胡明勇	联系方式：010-56051846 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
保荐代表人姓名：刘恺伦	联系方式：010-56051854 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），拓荆科技股份有限公司（简称“公司”或“拓荆科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。公司首次公开发行股票于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市，并由招商证券股份有限公司担任保荐人。

2025 年 11 月，公司因 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项聘任中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”、“保荐机构”）作为保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信建投证券承接。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	保荐机构、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	保荐人、保荐代表人已协助和督促拓荆科技建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，符合相关法律法规的要求。2025 年度，拓荆科技无控股股东、实际控制人。拓荆科技及其董事、高级管理人员、核心技术人员已知晓其在相关规则下的各项义务。
2	保荐机构、保荐代表人应当持续督促上市	2025 年度，拓荆科技无控股股东、实

序号	工作内容	持续督导情况
	<p>公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。</p>	<p>际控制人。</p> <p>保荐人、保荐代表人已持续督促拓荆科技充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，拓荆科技信息披露真实、准确、完整、及时、公平。</p> <p>保荐人、保荐代表人已对拓荆科技制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。</p>
3	<p>上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p>	<p>2025 年度，拓荆科技无控股股东、实际控制人。</p> <p>保荐人、保荐代表人已督促拓荆科技对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露；已持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促其及时、充分履行承诺；未发现上市公司披露、履行或者变更承诺事项存在不符合法律法规及其他相关规定的情形。</p>
4	<p>保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。</p>	<p>保荐人、保荐代表人已督促拓荆科技积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。</p>
5	<p>保荐机构、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐机构、保荐代表人应当发表意见予以说明。</p>	<p>2025 年度，保荐人、保荐代表人持续关注拓荆科技运作，对拓荆科技及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料等方式，关注拓荆科技日常经营和股票交易情况。2025 年度，拓荆科技不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。</p>
6	<p>上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。</p>	<p>2025 年度，拓荆科技股票交易未出现严重异常波动。</p>
7	<p>保荐机构、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上</p>	<p>2025 年度，拓荆科技无控股股东、实际控制人。保荐人、保荐代表人已督促控拓荆科技第一大股东、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的</p>

序号	工作内容	持续督导情况
	市公司的影响等情况。	股份减持承诺,并持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
8	保荐机构、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况,督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐人、保荐代表人已关注拓荆科技使用募集资金的情况,督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间,保荐机构和保荐代表人未发现拓荆科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间,公司主要的风险事项如下:

(一) 核心竞争力风险

随着半导体行业技术持续迭代升级,下游客户对半导体设备的品类拓展、性能指标及工艺适配性的要求不断提升。公司需持续保持高水平研发投入,以巩固产品核心竞争力与技术先进性。若未来公司未能精准把握下游客户产线升级、设备迭代及工艺演进趋势,或技术创新成果与客户实际需求不匹配,将导致公司产品无法满足下游产线规模化生产与工艺适配要求,进而对公司经营业绩、市场地位及持续发展能力产生不利影响。

(二) 经营风险

1、产品验收周期较长风险

薄膜沉积设备所沉积的薄膜技术参数直接影响芯片性能。生产中不仅需要成膜后检测薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标,还需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后,对最终芯片产品进行可靠性和生命周期测试,以衡量薄膜沉积设备是否最终满足技术标准。因此,晶圆厂对薄膜沉积设备所需要的验证时间较长。同时,公司应用于三维集成领域的先进键合设备作为高精度专用装备,键合精度达百纳米级,当前仍处于产业化初期,是高带宽存储器、三维闪存芯片、3D DRAM、异构集成芯片等领域的核心支撑技术。由于部分产业应用尚未完成规模化验证,存在定制化需求攀升的技术风险,可能引致研发投入超预期增长及验证周期延长,导致公司收入确认及回款周期延后,增加资金链

压力，对财务稳健性构成潜在风险。

2、市场竞争风险

半导体设备行业具有很高的技术壁垒和市场壁垒。目前公司的竞争对手主要为国际知名半导体设备制造商，由于半导体产线对于设备技术水平、稳定性、设备间配合度要求极高，因此半导体设备的验证周期与导入周期一般较长，与中国大陆半导体专用设备厂商相比，国际领先制造商往往在客户端具备一定先发优势；此外，存在国内潜在竞争对手进入本行业参与竞争的可能性，引起行业竞争格局的变化。尽管公司的主要产品与核心技术目前具备较大的领先地位与竞争优势，但若无法有效应对市场竞争环境、维持技术创新迭代能力并保持产品竞争优势，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能会受到一定影响。

3、下游客户扩产不及预期的风险

下游客户扩产规模决定了半导体专用设备的市场空间。晶圆厂的扩产投资具有一定的周期性。如果下游晶圆厂的投资强度降低，公司将面临市场需求下降的风险，对于公司的经营业绩会造成不利影响。

4、供应链安全风险

近年来，复杂的国际形势加剧了全球供应链的不稳定性。目前，公司的部分零部件暂时仍然需要向国外供应商采购。如果国际贸易摩擦进一步加剧，可能出现上述国外供应商受相关政策影响减少或者停止对公司部分零部件的供应，可能会影响公司产品生产能力、生产进度和交货时间，降低公司的市场竞争力。

5、技术研发风险

近年来，半导体芯片制程和技术迭代速度持续加快，行业已逐步迈入后摩尔时代，半导体领域的新结构、新材料不断涌现，下游客户对半导体设备的技术要求也日益提升。在此背景下，公司持续保持高强度的研发投入，紧跟芯片制造工艺、基础学科的发展方向，立足国内半导体制造产业实际需求与产线迭代规律，继续深化与客户协同研发的机制，精准锚定其特定工艺材料、特定制造工序高端半导体设备的核心要求，系统性规划工艺优化和迭代方向，专项开发定制化、高适配度的解决方案，支撑下游芯片制造厂技术升级和快速扩产。若行业技术发展

趋势及下游研发进展发生重大变化，下游芯片制造厂未延续此前与公司协同研发的技术路径，公司技术研发将可能出现与下游技术研发路线不同步等情况，可能出现无法及时响应下游客户对产线设备和工艺技术的需求并对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

1、政府补助政策变动风险

公司在 2025 年收到的政府补助主要是对公司研发投入的支持。如果公司未来不能持续获得政府补助，或政府补助显著降低，公司将需要投入更多自筹资金用于研发，进而影响公司现金流。此外，政府补助的减少，也会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

2、税收优惠风险

2025 年公司享受高新技术企业所得税及国家关于集成电路领域的相关税收优惠政策，如果国家上述税收优惠政策发生变化，则可能面临因税收优惠减少或取消而降低盈利的风险。

（四）行业风险

近年来，受下游新兴需求不断涌现、半导体产业向中国大陆转移、客户资本性支出增加等因素影响，国内半导体设备市场需求整体呈持续增长趋势。但由于半导体行业受国际经济波动、终端消费市场需求变化等方面影响较大，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在半导体行业上行周期中，半导体芯片制造厂往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求；若未来半导体行业处于下行周期中，半导体芯片制造厂往往会削减资本性支出，减少对半导体设备的需求。前述宏观环境及行业波动造成的半导体设备需求波动，可能会为公司的业务发展和经营业绩带来一定波动性风险。

（五）宏观环境风险

当前全球经济增长承压，叠加地缘政治冲突、关税政策变化加剧，可能影响半导体行业发展增速、供应链安全及终端市场需求，继而影响半导体设备行业整体需求。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，拓荆科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025年1-12月	2024年1-12月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	6,519,094,874.63	4,103,453,853.41	58.87
归属于上市公司股东的净利润	926,703,966.52	688,154,723.26	34.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	723,146,885.28	356,137,942.78	103.05
经营活动产生的现金流量净额	3,633,207,138.20	-282,525,331.06	不适用
主要会计数据	2025年12月末	2024年12月末	本期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,609,957,217.37	5,280,154,359.39	25.18
总资产	19,823,566,917.19	15,314,166,086.88	29.45

2025年，公司主要财务指标如下表所示：

单位：元

主要财务指标	2025年1-12月	2024年1-12月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	3.32	2.48	33.87
稀释每股收益（元/股）	3.29	2.46	33.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.59	1.28	102.34
加权平均净资产收益率（%）	15.77	14.10	增加 1.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.30	7.30	增加 5.00 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	13.18	18.42	减少 5.24 个百分点

2025年，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、2025年度，公司实现营业收入 65.19 亿元，同比增长约 58.87%，主要原

因如下：

公司始终坚持高强度研发投入与自主创新，2025 年，公司应用于先进制程领域的新产品、新工艺实现规模化量产，产品销售取得放量突破。公司 PECVD 系列设备实现销售收入约 51.42 亿元，同比增长 75.27%，主要系公司应用于先进存储、先进逻辑领域的基于新型设备平台（PF-300T Plus 和 PF-300M）和新型反应腔（pX 和 Supra-D）开发的 PECVD Stack（ONO 叠层）、ACHM 以及 PECVD Bianca 等产品批量通过客户验证，进入规模化量产阶段，并实现收入转化。公司 ALD 设备实现销售收入约 3.01 亿元，同比大幅增长 191.82%，主要系公司 PE-ALD SiO₂、SiN、SiCO 等多款设备量产规模快速提升，Thermal-ALD 首台 TiN 工艺产品通过客户验证，收入同比实现大幅度增长。公司混合键合设备实现营业收入 1.36 亿元，同比增长 41.92%，主要系公司晶圆对晶圆混合键合产品持续获得订单，并有多台通过客户验证，量产规模大幅提升，此外，公司首台晶圆对晶圆熔融键合产品通过客户验证，实现收入转化。

公司持续优化客户结构，在巩固国内龙头晶圆厂合作的同时，成功导入多家新客户，市场渗透率进一步提升。截至 2025 年末，合同负债达 48.52 亿元，相较 2024 年年末增长 62.66%，主要系同比预收客户货款大幅增加所致。截至 2025 年末，公司在手订单金额约为 110 亿元，为公司后续收入持续增长奠定了坚实的基础。

2、2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9.27 亿元，同比增加 34.67%，主要系：（1）营业收入同比大幅增加 24.16 亿元，致毛利额同比增加 5.68 亿元；（2）公司持续加强成本管控，期间费用率继续下降，规模效应进一步释放利润空间。

3、2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.23 亿元，同比增长 103.05%，增幅大于归属于上市公司股东的净利润增长率，主要系：（1）日常经营活动产生的归属于母公司股东的净利润大幅增加；（2）非经常性损益同比减少，主要系公司对外投资产生的交易性金融资产的公允价值变动损益同比减少约 1.33 亿元。

4、2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 36.33 亿元，同比增加

39.16 亿元，主要系 2025 年度预收货款及销售回款金额达到 94.84 亿元，同比增加 40.68 亿元，而经营活动现金流出同比仅增加 2.36 亿元。

六、核心竞争力的变化情况

拓荆科技长期专注于高端半导体专用设备的研发与产业化，始终坚持自主创新，持续为半导体行业 and 客户提供具有竞争力的产品。公司在战略布局、研发能力、技术水平、产品覆盖、客户资源、人才队伍建设、供应链稳定等方面形成竞争优势，具体体现为：

（一）战略定位明确，围绕自身发展战略稳步推进产业布局

公司自设立时便确定了聚焦高端半导体薄膜沉积设备领域这一战略定位，并持续围绕国家战略方向、市场前沿技术、行业发展趋势及客户应用需求等方向进行前瞻性布局，在巩固薄膜沉积设备优势的基础上，面向后摩尔时代技术迭代方向，公司于 2018 年即开始布局三维集成设备产品并实现了显著成果，形成“薄膜沉积+三维集成”的产品格局。公司目前已形成 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备产品，以及晶圆对晶圆混合键合、晶圆对晶圆熔融键合、芯片对晶圆混合键合等三维集成设备产品，已广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器（CIS）等领域。

公司以“建立世界领先的半导体设备公司”为愿景，通过在薄膜沉积设备领域、三维集成领域的技术积累和快速发展，已经成为国内半导体设备行业的领军企业。同时，公司遵循战略方向稳步扩张，持续深耕现有核心赛道，推动在薄膜沉积设备和三维集成设备领域的纵深发展，并前瞻性布局前沿技术赛道，提前抢占行业未来发展制高点，稳步推进横向发展，适时进行产业链整合与业务延伸，不断提升综合竞争力与行业影响力。

（二）自主研发能力突出，支撑产业链协同创新

公司始终坚持自主创新研发，以国家战略方向、前沿技术趋势及客户应用需求为导向开展研发工作，实现薄膜沉积设备和三维集成设备的全研发环节覆盖，在硬件设计、工艺开发和系统集成等多方面，实现了核心技术自主可控。凭借深

厚的整机装备自主研发经验和技術积累，公司保证了较高的研发自主性和灵活性，面向客户先进制程工艺需求，能够快速实现先进产品技术研发，并高效完成研发阶段向生产阶段的快速转化，及时响应下游的供货需求。

公司的研发战略为“紧跟产业趋势、产品提前布局”，围绕先进制程和后摩尔时代带来的技术迭代需求，进行超前于当前制造节点技术代际的前瞻性基础研究与工艺开发，提前构筑技术壁垒。在此基础上，公司基于自身技术优势，与芯片制造厂在设备选型阶段即与客户开展协同式研发，精准适配客户特定工艺材料、特定制造工序的薄膜性能要求，实现常态化互动与协同创新。公司可以结合客户特定需求，提供定制化、适配度高的解决方案，既满足了下游芯片制造厂快速扩充产能的需求，也通过持续的技术迭代，配合客户实现技术升级。此外，公司先后承担多项国家重大专项/课题，整合产业资源参与技术攻坚，形成了覆盖研发、生产、供应各环节的协同创新体系，支撑产业链整体技术水平提升。

（三）核心技术领先，工艺应用覆盖全面

公司自成立以来，持续深耕高端半导体设备领域，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并达到国际先进水平。公司的核心技术广泛应用于主营业务产品中，在薄膜沉积设备领域，涵盖了先进薄膜工艺设备设计技术、反应模块架构布局技术、半导体制造系统高产能平台技术、等离子体稳定控制技术，解决了半导体制造中纳米级厚度薄膜均匀一致性、薄膜表面颗粒数量少、快速成膜、设备产能稳定高速等关键难题，在保证实现薄膜工艺性能的同时，通过设计定制化高产能平台，提升设备的生产效率，进而提升客户产线的产能，减少客户产线的生产成本。此外，公司面向三维集成领域应用，形成了载片与器件晶圆高速高精度对准技术、晶圆级键合实时对准技术、芯片拾取与键合技术，实现较高的晶圆键合精度，并大幅提高设备产能。

公司通过自主研发，形成了一系列独创性的设计，构建了完善的知识产权体系并取得了多项自主知识产权。

公司依托自主核心技术体系，构建了完善的产品矩阵，在所聚焦的产品系列中实现工艺全面、深度的覆盖，量产设备产品性能达到了国际同类设备先进水平，并持续迭代升级，快速响应客户先进技术需求。在薄膜沉积设备领域，推出了

PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 为核心的全系列薄膜沉积设备，其中，PECVD 设备已实现薄膜材料的全面覆盖，在集成电路逻辑芯片、存储芯片等领域广泛应用；在 ALD 设备方面，推出了等离子体增强原子层沉积（PE-ALD）和热处理原子层沉积（Thermal-ALD）设备并实现量产，目前国内装机量及工艺覆盖均领先；HDPCVD、SACVD、Flowable CVD 设备可实现芯片内不同深浅三维结构的填充需求，已在多条产线实现产业化应用。在三维集成设备领域，推出的晶圆对晶圆混合键合设备、熔融键合设备等系列产品已成功应用于先进存储、图像传感器等领域，可以为后摩尔时代技术发展提供支撑。

（四）国内领先的行业地位及丰富的客户资源优势

公司已构建较为完善的薄膜沉积设备、三维集成设备的产品矩阵，并实现国产化突破与规模化应用。薄膜沉积设备方面，公司凭借优异的产品性能表现持续获得客户订单，不断扩大量产规模。截至 2025 年末，公司产品已进入约 100 条芯片制造厂生产线；累计出货反应腔已超过 3,400 个，且应用于先进制程领域的高性能反应腔占比不断提高；在客户端产线生产产品的累计流片量已突破 4.57 亿片；客户端设备平均稳定运行时间（Uptime）超过 90%（达到国际主流水平）。此外，在三维集成设备方面，公司推出多款核心产品，相关产品陆续通过客户验证并进入稳步放量阶段，是国内先进混合键合设备领域技术领先厂商。

公司产品已进入逻辑芯片、存储芯片、先进封装等领域，实现主流芯片制造厂的深度覆盖与批量供货，适配从成熟制程到先进制程的工艺应用需求。公司与客户的合作模式已从单纯的设备供应升级为“协同研发+定制化适配+长期服务”的深度绑定模式，合作关系呈现稳定性强、覆盖面广、协同深入的特点，构建了可持续的客户生态体系。

（五）拥有优秀的技术研发及管理团队

公司已构建起一支兼具国际视野与产业深度的高端半导体专用设备技术研发及管理团队，通过“外部引智+内部育能”双轮驱动，形成了稳定、高效且具备创新活力的人才梯队，为技术突破与产品迭代提供核心支撑。

在人才梯队建设方面，公司构建了完善的人才引进和培养体系。一方面，通过长效股权激励机制、市场化薪酬福利与清晰的职业发展路径，持续吸引行业内

的资深人才，其在整机设计、工艺开发、系统控制、软件迭代等关键领域的技术积累，有力带动研发团队实现产品创新；另一方面，公司自成立以来始终重视本土科研团队自主培养，伴随 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD、三维集成设备等核心产品从研发到量产的全周期历练，本土团队已成长为技术攻坚的中坚力量。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员规模达 726 人，占员工总数的 42.81%，形成覆盖半导体设备研发全环节的学科布局。其中，博士研究生 65 人，占研发人员的 8.95%，硕士研究生 425 人，占研发人员的 58.54%，团队成员兼具扎实的专业知识储备与丰富的产线验证经验，在技术研发、工艺优化等环节分工明确、协同高效，保障成熟产品稳定迭代与先进产品的前瞻性技术研发。

2025 年度，公司核心技术团队稳定，为技术研发的连续性与产品创新的持续性提供了坚实保障。

（六）建立起稳定供应链生态

公司建立了完善的供应链管理体系，吸纳积累全球半导体行业内的优质供应链资源，关键零部件采用“多源采购”模式，并与核心供应商建立长期战略合作关系，确保关键部件的及时稳定供应。在此基础上，公司与供应商构建了协同创新机制，在开展新产品、新技术开发过程中保持与供应商的深度协作，确保部件产品性能达到公司先进需求，形成稳定的、互信的、共赢的供应链生态。这一体系为公司产品研发、量产交付与持续创新提供了可靠保障。

七、研发支出变化及研发进展

2025 年度，公司研发投入总额 85,927.42 万元，较上年增加 13.66%，其中 2025 年度符合资本化条件的研发项目支出金额为 8,969.71 万元，2025 年度研发投入资本化比重 10.44%。

公司始终在高端半导体专用设备领域深耕，并专注于薄膜沉积设备及三维集成设备的研发与产业化，拥有多项自主知识产权和核心技术。截至 2025 年末，公司累计申请专利 2,140 项（含 PCT）、获得授权专利 707 项；2025 年度，公司新增申请专利 498 项（含 PCT）、新增获得专利 244 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位:人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022 年 4 月 14 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	227,283.12
其中：超募资金金额	112,730.08
减：直接支付发行费用	14,523.40
二、募集资金净额	212,759.73
减：	
以前年度已使用金额	168,678.77
本年度使用金额	21,811.98
完结项目剩余资金永久补充流动资金	61.18
银行手续费支出	1.86
加：	
募集资金利息收入	7,149.79
三、报告期期末募集资金余额	29,355.73

公司 2025 年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2025 年度，公司无控股股东、实际控制人。公司现任董事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股票情况及 2025 年期间所持股份的增减变动情况如下表

所示：

姓名	职务	2025年初持股数	2025年末持股数	2025年期间股份增减变动量	增减变动原因
吕光泉	董事长	1,095,200	1,095,200	0	不适用
袁训	董事	0	0	0	不适用
张昊玳	董事	0	0	0	不适用
张憬怡	董事	0	0	0	不适用
尹志尧	董事	0	0	0	不适用
刘静	董事、总经理	60,236	90,472	30,236	公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持
刘胜	独立董事	0	0	0	不适用
黄宏彬	独立董事	0	0	0	不适用
赵国庆	独立董事	0	0	0	不适用
陈新益	副总经理、核心技术人员	18,904	30,608	11,704	公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持
宁建平	副总经理、核心技术人员	16,428	28,752	12,324	公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持
牛新平	副总经理、核心技术人员	16,428	24,856	8,428	公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持
许龙旭	副总经理	19,714	29,571	9,857	公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持
赵曦	副总经理、董事会秘书	28,696	48,290	19,594	公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持
杨小强	财务负责人	4,971	8,662	3,691	公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持
孟亮	核心技术	0	4,300	4,300	公司 2023 年限制性

姓名	职务	2025年初持股数	2025年末持股数	2025年期间股份增减变动量	增减变动原因
	人员				股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属及个人减持
杨家岭	核心技术人员	0	23,704	23,704	公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属及个人减持
邓浩	核心技术人员	500	0	-500	2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属及个人减持
郭万里	核心技术人员	0	0	0	不适用

截至 2025 年 12 月 31 日，公司现任董事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份不存在质押、冻结情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

胡明勇

胡明勇

刘恺伦

刘恺伦

中信建投证券股份有限公司



2026年5月11日